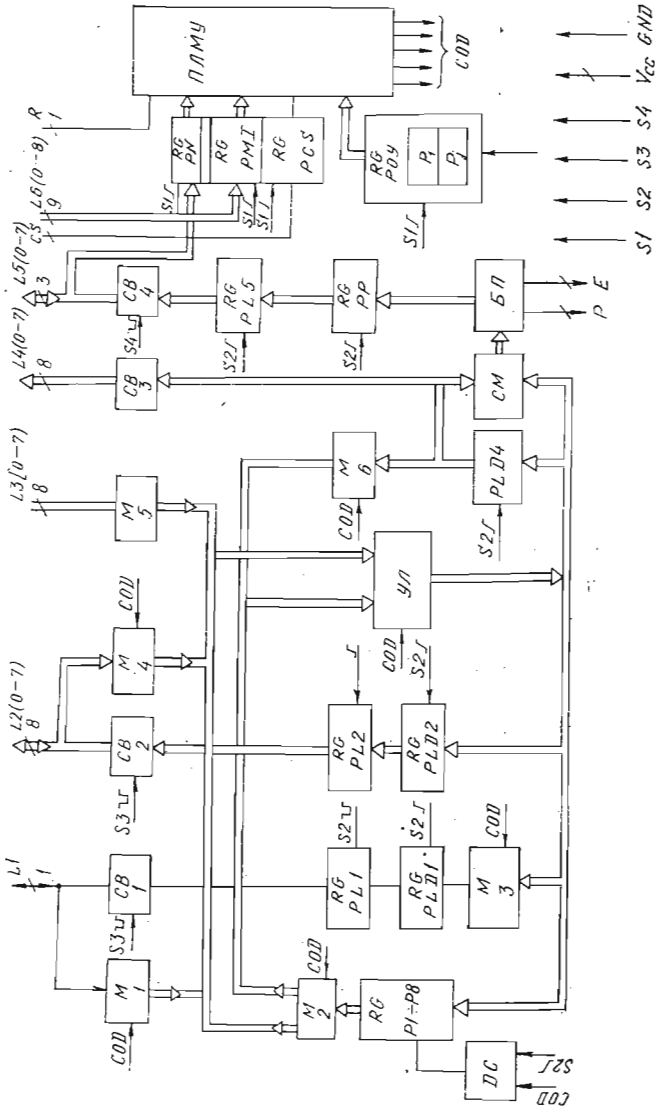


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



Принятые сокращения в схеме

- | | |
|---|--|
| <i>L1</i> —двунаправленная битовая магистраль | <i>P</i> и <i>E</i> —выходы признаков |
| <i>L2</i> —восьмиразрядная двунаправленная магистраль | <i>R</i> —вход опроса схемы приоритета |
| <i>L3</i> —входная восьмиразрядная магистраль | <i>M</i> —мультиплексер |
| <i>L4</i> —выходная восьмиразрядная магистраль | <i>CB</i> —схема вывода |
| <i>L5</i> —двунаправленная трехразрядная магистраль | <i>RG P1—P8</i> —регистры общие |
| <i>L6</i> —девятиразрядная входная магистраль | <i>RG PLD</i> —регистры магистрали |
| <i>S1—S4</i> —управляющие синхросигналы | <i>RG PL</i> —регистры буферные |
| <i>MK</i> —микрокоманда | <i>УЛ</i> —устройство логическое |
| <i>СОД</i> —код операции | <i>RG PP</i> —регистр приоритета |
| <i>CS</i> —выборка кристалла | <i>RG PM</i> —регистр микрокоманд |
| | <i>RG PCS</i> —регистр выборки кристалла |
| | <i>RG ПОУ</i> —регистр остаточного управления |
| | <i>ПЛМУ</i> —программируемая логическая матрица управления |
| | <i>БП</i> —блок приоритета |
| | <i>СМ</i> —схема маскирования |

Назначение выводов

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1—вход <i>S1</i> | 17—вход <i>L6</i> [3] | 33—вход <i>L3</i> [5] |
| 2—вход <i>S2</i> | 18—вход <i>L6</i> [5] | 34—выход <i>L4</i> [5] |
| 3—вход <i>S3</i> | 19—вход <i>L6</i> [6] | 35—вход/выход <i>L2</i> [5] |
| 4—вход <i>S4</i> | 20—вход <i>L6</i> [8] | 36—вход <i>L3</i> [6] |
| 5—вход/выход <i>L2</i> [∅] | 21—вход <i>L6</i> [7] | 37—выход <i>L4</i> [6] |
| 6—выход <i>L4</i> [∅] | 22—вход <i>CS</i> | 38—вход/выход <i>L2</i> [6] |
| 7—вход <i>L3</i> [∅] | 23—вход <i>R</i> | 39—вход <i>L3</i> [7] |
| 8—вход/выход <i>L2</i> [1] | 24—земля | 40—выход <i>L4</i> [7] |
| 9—выход <i>L4</i> [1] | 25—+5 В | 41—вход/выход <i>L2</i> [7] |
| 10—вход <i>L3</i> [1] | 26—вход <i>L6</i> [2] | 42—выход <i>E</i> |
| 11—вход/выход <i>L2</i> [2] | 27—вход <i>L6</i> [1] | 43—выход <i>P</i> |
| 12—выход <i>L4</i> [2] | 28—вход <i>L6</i> [∅] | 44—вход/выход <i>L5</i> [∅] |
| 13—вход <i>L3</i> [2] | 29—вход <i>L6</i> [4] | 45—вход/выход <i>L5</i> [1] |
| 14—вход/выход <i>L2</i> [3] | 30—вход <i>L3</i> [4] | 46—вход/выход <i>L5</i> [2] |
| 15—выход <i>L4</i> [3] | 31—выход <i>L4</i> [4] | 47—вход/выход <i>L1</i> |
| 16—вход <i>L3</i> [3] | 32—вход/выход <i>L2</i> [4] | 48—+5 В |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25±5° С)

- | | |
|---|------------------|
| Напряжение питания | +5 В±5% |
| Выходной ток низкого уровня: | |
| по выходам <i>L4</i> , <i>P</i> , <i>E</i> | не более 0,05 МА |
| по входам/выходам <i>L1</i> , <i>L2</i> , <i>L5</i> | не более 0,45 МА |

583ВМ1А
583ВМ1Б

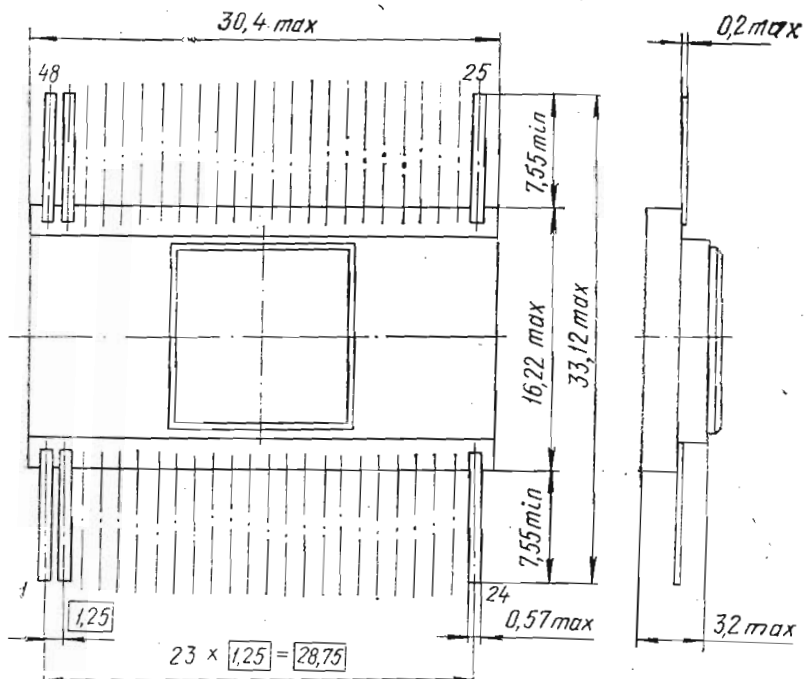
МИКРОПРОЦЕССОР ЛОГИЧЕСКИЙ

Напряжение инжектора	от 1,0 до 1,4 В
Выходное напряжение высокого уровня	не более 0,4 В
Помехоустойчивость	не менее 0,4 В
Время цикла	не более 1 мкс
Время задержки распространения при включении (выключении):	
по входу $S3$ — выходам $L1, L2, L5$	не более 150 нс
по входу $L1, L2, L3$ — выходам P, E	не более 300 нс
по входу R — выходам P, E	не более 250 нс
по входу $S2$ — выходам $L1, L2, L5$ для микро- схем:	
583ВМ1А	не более 250 нс
583ВМ1Б	не более 350 нс
по входу $S1$ — выходам P, E для микросхем:	
583ВМ1А	не более 400 нс
583ВМ1Б	не более 500 нс
по входу $S2$ — выходу $L4$ для микросхем:	
583ВМ1А	не более 250 нс
583ВМ1Б	не более 350 нс

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение на входе микросхемы	5,5 В
Минимальное отрицательное напряжение на входе микросхемы	0,4 В
Максимальный ток инжектора	500 мА
Максимальное напряжение на выходе закрытой схемы	6,0 В
Минимальное отрицательное напряжение на выхо- де микросхемы	0,3 В
Максимальная длительность фронта и среза вход- ного сигнала	300 нс
Максимальная суммарная емкость нагрузки	200 пФ

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ



Масса — не более 4,5 г

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация:

диапазон частот от 1 до 5000 Гц
ускорение до 40 g

Многokратные удары:

ускорение до 150 g
длительность удара от 1 до 3 мс

Одиночные удары:	
ускорение	до 1000 g
длительность удара	от 0,2 до 1,0 мс
Линейные нагрузки:	
ускорение	до 500 g
Температура окружающей среды	от минус 60 до +125° С
Многokrатные циклические изменения температуры	от минус 60 до +125° С
Атмосферное давление	от 5 мм рт. ст. до 3 атм

Иней, роса.
Соляной туман.
Среда, зараженная плесневыми грибами.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка [○]	50 000 ч
Срок сохраняемости [○]	25 лет

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—80 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 100 В.

При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхемы в контактирующих устройствах замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

[○] В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.